Каталог продукции

Усилители мощности LDMOS

Усилители мощности LDMOS повышают мощность RF с помощью МОП-транзисторов с латеральной диффузией. Согласование, смещение, пики сигнала и полный тепловой путь определяют рабочие пределы.



Продукция: 2

Редакция: 2 · Дата редакции: 2026-11-11



LCPAM-20-520-200A

Модуль усилителя мощности RF LDMOS 20–520 МГц, 200 Вт в насыщении

Модуль с выходным каскадом LDMOS охватывает 20–520 МГц с типичной мощностью насыщения 200 Вт. Мощность при компрессии 1 дБ отдельно задана как типичные 50 Вт, малосигнальное усиление — типично 53 дБ.

Рабочая частота: Обозначение: BW; Минимум: 20; Максимум: 520; Единица: MHz

Выходная мощность RF в насыщении: Обозначение: Psat; Типовое: 200; Единица: W

Мощность выхода при компрессии 1 дБ: Обозначение: P1dB; Типовое: 50; Единица: W

Малосигнальное усиление: Обозначение: G; Типовое: 53; Единица: dB

25 °C; 50 Ω

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCPAM-20-520-350

Усилитель LDMOS RF 20–520 MHz, типичная мощность насыщения 350 W

Усилитель LDMOS охватывает 20–520 MHz с типичной мощностью насыщения 350 W и выходом 150 W при компрессии 1 dB. Типичные усиление — 56 dB, ток при 350 W — 29 A, питание — 48 VDC.

Рабочая частота: Обозначение: BW; Минимум: 20; Максимум: 520; Единица: MHz

Мощность выхода при компрессии 1 дБ: Обозначение: P-1dB; Типовое: 150; Единица: W

Мощность выхода RF @ PSAT: Обозначение: PSAT; Типовое: 350; Единица: W

Усиление мощности @ PSAT: Обозначение: Gp; Типовое: 56; Единица: dB

+48.0VDC; 25°C; 50Ω

Подробнее о продукте Техническое описание изделия

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.